

シリコンNPNエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)
SILICON NPN EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

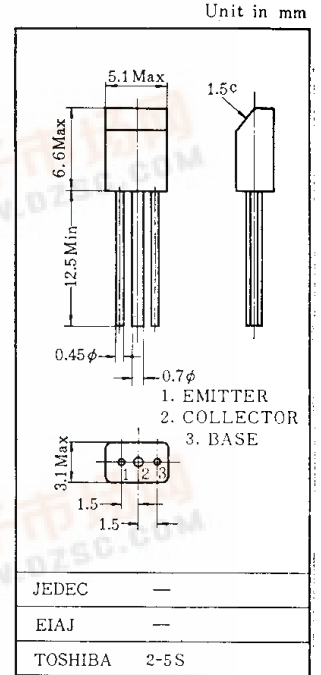
2SC1166

- 励振段増幅用
- 電圧増幅用
- Driver Stage Amplifier Applications.
- Voltage Amplifier Applications.

- 高耐圧です; $V_{CE0} \geq 50V$
- 許容コレクタ損失が大きい: $P_C = 600mW$ ($T_a = 25^\circ C$)
- 2SA661 とコンプリメンタリになり, コンプリメンタリ出力回路の励振用として最適です.
- Complementary to 2SA661

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	200	mA
エミッタ電流	I_E	-200	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



アクセサリはRH-16を適用
RADIATOR HOLDER RH-16

電氣的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 20V, I_E = 0$	—	—	100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 5V, I_C = 0$	—	—	100	nA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10mA, I_B = 0$	50	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 0.1mA, I_C = 0$	5	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE} = 2V, I_C = 50mA$	40	100	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = 2V, I_C = 200mA$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100mA, I_B = 10mA$	—	—	0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 2V, I_C = 200mA$	—	—	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10V, I_E = -10mA$	70	120	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	9	—	pF

Note; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し, 現品表示してあります.

According to the vlaue of $h_{FE(1)}$, the 2SC1166 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SC1166—R	40	80
2SC1166—O	70	140
2SC1166—Y	120	240
2SC1166—GR	200	400

$P_C - T_a$

